

平成 22 年 2 月吉日

各 位

名古屋大学赤崎記念研究センター

センター長 水谷 孝

### 第 9 回赤崎記念研究センターシンポジウム並びに懇親会のご案内

拝啓 寒さ厳しき折、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

今年も赤崎記念研究センターシンポジウムを開催する時期がやって参りました。本シンポジウムは 2001 年の第 1 回開催から数えて第 9 回目となりました。これまでの開催主旨を引き継ぎ、窒化物半導体の新たな展開をテーマとして関係の先生方にご講演をお願いしております。皆様のご参加を頂きますようご案内申し上げます。

このたびも、名古屋大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（ラボラトリー長 齋藤弥八教授）、日本学術振興会「ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会」（委員長 吉川明彦教授）、名城大学窒化物半導体研究センター（センター長 赤崎勇教授）の協賛を得ての開催を予定しております。ご関係の皆様方に御礼を申し上げます。

シンポジウム終了後、懇親会を企画致しました。本センター設立と運営に多大なお力を頂いております赤崎勇先生を囲んで歓談のひとつきをお過ごしいただけますよう、多数のご参会をお待ち申し上げます。

敬具

記

#### 第 9 回 赤崎記念研究センターシンポジウム

主催：名古屋大学 赤崎記念研究センター

協賛：名古屋大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー

日本学術振興会「ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会」

名城大学窒化物半導体研究センター

1. 日 時： 平成 22 年 3 月 12 日（金） 10:20 ～ 17:00  
17:15 ～ 懇親会
2. 場 所： ルブラ王山  
名古屋市千種区覚王山通 8-18 TEL：052-762-3151  
[http:// rubura.org/index.html](http://rubura.org/index.html)  
地下鉄東山線池下駅下車 2 番出口(サンクレア池下地下 1 階)より徒歩 3 分
3. テーマ： 「窒化物半導体研究の新展開：新規デバイスの創出をめざして」  
(プログラム別紙)
4. 連絡先： 名古屋大学大学院工学研究科 量子工学専攻 水谷研究室：磯輪  
464-8603 名古屋市千種区不老町  
TEL：052-789-5230 FAX：052-789-5232  
e-mail：isowa@nuee.nagoya-u.ac.jp

**9th Akasaki Research Center Symposium  
"To the New Horizon of the Nitride Research"**

**March 12, 2010  
Hotel Rubura Ohzan**

Organized by  
Nagoya University Akasaki Research Center  
*In cooperation with*  
Nagoya University Venture Business Laboratory  
JSPS 162nd Committee on Wide Bandgap Semiconductor Photonic and Electronic Devices  
Meijo University Research Center for Nitride Semiconductors

**【1】 Growth and Characterization-1**

**10:20-11:00**

“Growth, structural and optical properties of GaN quantum dots: Stranski-Krastanow growth mode versus axial nanowire heterostructures”

B. Daudin (*CEA Grenoble*)

**11:00-11:40**

“Solvothermal growth of ZnO and GaN single crystals”

T. Fukuda and D. Ehrentraut (*Tohoku University*)

**11:40-12:00**

“MOVPE growth and emission properties of AlGa<sub>N</sub> with high AlN mole fraction”

K. Hiramatsu, H. Miyake, Y. Shimahara, and H. Taketomi (*Mie University*)

**【2】 Devices**

**13:20-14:00**

“New Perspectives for GaN-Based Power Devices”

D. Ueda (*Panasonic*)

**14:00-14:20**

“Analysis of transient behavior of AlGa<sub>N</sub>/Ga<sub>N</sub> MOSFETs”

T. Mizutani and Y. Hayashi (*Nagoya University*)

**14:20-14:40**

“How to realize 100% quantum efficiency from UV, visible to IR by nitride-LEDs?”

H. Amano, M. Iwaya, S. Kamiyama and I. Akasaki (*Meijo University*)

**【3】 Growth and Characterization-2**

**15:00-15:40**

“Status of AlGa<sub>N</sub>/Ga<sub>N</sub> HEMT heterostructures grown by molecular beam epitaxy”

Y. Cordier (*CNRS-CRHEA*)

**15:40-16:00**

“Crystal growth of GaN on etched Si substrate”

Y. Honda, T. Tanikawa, B. Kim, T. Murase, M. Yamaguti, and N. Sawaki (*Nagoya University*)

**16:00-16:20**

“Growth and characterization of nitride semiconductors by MOVPE reactor installed in the X-ray CTR measurements system”

Y. Takeda, H. Kamiya, K. Ninoi, G.X. Ju, S. Fuchi, and M. Tabuchi (*Nagoya University*)

**16:20-17:00**

“Acceptor doping in GaN”

B. Monemar (*Linkoeping University*)

**Buffet Party  
17:15-19:15**

第9回 赤崎記念研究センターシンポジウム 参加申込書

締め切り  
3月3日

日時：平成 22年 3月 12日 (金) 10:20 ~ 17:00  
 場所：ルブラ王山 (名古屋市千種区覚王山通)  
[http:// rubura.org/index.html](http://rubura.org/index.html)  
 地下鉄東山線池下駅下車 2番出口(サンクレア池下地下1階)より徒歩3分  
 懇親会：平成 22年 3月 12日 (金) 17:15 ~ 19:15  
 会費 3,000円 (当日申し受けます)

※当日昼食 (別途 1,000円) をご用意させていただきます。準備の都合上、ご希望の方は申込書にご記入をお願い致します。

【シンポジウム参加申込】

氏名	(フリガナ)	連絡先	TEL:
			FAX:
所属			
住所 (勤務先)			
メールアドレス			
懇親会 (3,000円)	参加	不参加	昼食 (1,000円) 要 不要
氏名	(フリガナ)	連絡先	TEL:
			FAX:
所属			
住所 (勤務先)			
メールアドレス			
懇親会 (3,000円)	参加	不参加	昼食 (1,000円) 要 不要

送付先：名古屋大学大学院工学研究科 量子工学専攻 水谷研究室：磯輪  
 464-8603 名古屋市千種区不老町  
 TEL : 052-789-5230 FAX : 052-789-5232  
 e-mail : isowa@nuee.nagoya-u.ac.jp  
 (上記内容を電子メールでお知らせ下さっても結構です)